Summary of JP 54-163399 A

A high dielectric constant composite comprising:

an insulating polymer, and

a charge transfer complex of high electroconductivity which makes a compound by which a part of structures are expressed with a formula

$$\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$$
Where $x = s$, s_e

among the portions used as the frame of a structural formula an electronic donor, and is blended at a rate not more than 10wt% in the above-mentioned insulating polymer.

(9日本国特許庁(IP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—163399

€ Int. Cl.2 H 01 B 3/30 H 01 G 4/18 識別記号 ②日本分類 62 C 622

59 E 101.32

6574-5E 6790-5E

庁内整理番号 ②公開 昭和54年(1979)12月25日

発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

矽高誘電率組成物

20特

昭353-72476 願

20出 願 昭53(1978) 6 月14日

79発 池野忍

門真市大字門真1048番地 松下

電工株式会社内

明者 三川礼

生駒市新旭ケ丘11-16

彻出 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

個代 理 人 弁理士 松本武彦

発明の名称

高誘電率組成物

2 特許請求の範囲

(1) 絶縁性ポリマーと、構造式の骨格となる部 分の構造のうち少なくとも一部の構造が式



CCK, X = S, Se

で裂わされる化合物を電子ドナーとし、上記絶録 性ポリマー中に10 wt 多以下の割合でプレンドさ れた高電導性の阻荷移動錯体とからなることを特 徴とする高誘電率組成物。

(2) 比抵抗値が 1 0⁵⁰ Ω-cm 以上である特許翻求 の範囲第(1)項記載の高勝電率組成物。

8. 発明の詳細な説明

との発用はフィルムコンデンサ材料等として用 いられる高誘電率組成物に関する。

そして、この発明は、薄膜形成能,加工性にす ぐれ、高勝電率でかつ低損失の高勝電率組成物を 提供することを目的とする。 .

近時、電子機器の小型化に伴い、その構成部品 てあるコンデンサも、より小型化および高性能化 されることが望まれている。

ところで、コンデンサの静電容量では、よく知 られているように、

 $C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 (A / t)$

・ ことに、 4: 誘電体の比誘電率(以下、単に

「餅電率」という)

4,: 真空の話電率

A:有効電框面積

t:誘電体の厚み

で表わされる。したがつて、コンデンサの静電容 量 C を大きくするためには、誘電率5c が高く薄膜 形成能のある時電体を用いることが望まれる。

ところが、従来より用いられているポリスチレ ン・ポリプロピレン・ポリエチレンテレフォレー ト・ポリカーポネート等の高分子材料は、誘電袋 性および加工性が良く、薄膜形成能を有し、かつ、 '善取りが可能であるというすぐれた利点を備えた

(2)

ものではあるが、その簡電率が2~4と低いため、いまだ十分に満足できるものではなかつた。そとで、このような高分子材料の簡電率を高めるための試みは従来からいくつかなされてきたが、シアノエチル化セルロース、ポリ弗化ビニリデン等で例示されるように、そのほとんどが双極子モーメントの大きな有機基の配向分板を利用するものであつた。

しかしたがら、配向分極の利用による高時間本 化には、1) 高分子のような内部粘性ののような内部粘性ののような内部粘性のして動かでは、 の双値子は高周波像では、は tan が増加する。 とができず、誘電率が低下したを性基のが増加する。 とができず、影電率が低下をなる。 とができず、影電率が低をとなる。 との解離を促進をを認めてもある。 が強ができず、ないとなる。 との解析を促進をといる。 が発生のである。 がはないる。 にないる。 にないる。

(3)

提供にすでに成功していた。しかし、その後も、 さらに一脳すぐれた高勝電率組成物を求めて実験、 研究を重ねる間に、式

$$\binom{s}{s} = \binom{s}{s}$$

で扱わされるテトラチオフルパレン(以下「TTF」と略す)とTCNQとからなる電荷移動錯体(CT 開催体)が、窒息で、有機物としての、その電導度は (の = 400 U/cm)を示し、 58°K で出し、 68°K で出し、 58°K で出し、 68°K で出し、 70°K でおけるととを増加し、 58°K ではし、 70°K ではし、 70°K ではし、 70°K ではないのでは、 70°K では、 70°K であっている。 では、 70°K では、 7

すなわち、この発明は、絶録性ポリマーと、 符 造式の骨格となる部分の構造のうち少なくとも一 わち、図面に模式的に示すように、跨智率のは、の性体 A 中に、勝智率のは、導電率のにはなから、対しておりに対している。なが、ないではなから、はなからないである。というなが、ないのでは、このは、このには対してでは、このには対してでは、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このには対して、このにはないのである。との複合物は高騰電率特性を示すのである。

この発明者らは、界面分極の利用による高誘電率化法のひとつとして、電導性の有機成分である低分子もしくは高分子のテトラシアノキノジメタン(以下、「TCNQ」と略す)塩を分散成分として用い、これを絶縁性ポリマーにプレンドすることも提案し、界面分極を利用した高誘電率組成物の

(4)

部の構造が式

$$\binom{x}{x} = \binom{x}{x}$$

CCK, X = S, Se

で表わされる化合物を電子ドナーとし、上記絶縁性ポリマー中に 10 wtが以下の割合でプレンドされた高電導性の電荷移動錯体とからなることを特徴とする高勝電率組成物をその要旨とするものである。

つぎに、この発用を詳しく説明する。

この発明に用いられる電荷移動錯体の電子ドナーは、構造式の骨格となる部分の構造のうち少な くとも一部の構造が式

$$\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$$

CCK, X = S, Se

で扱わされる化合物(以下「TTP類」と略す) である。4個のXはこれらのすべてがSまたはSe のみである場合と、一部がSとなり換部がSeとな る場合とがある。TTP類の例としては、たとえ ば下配(I)、(D)、(D)のようなものもしくはその筋導体が挙げられる。

 $\zeta \zeta \kappa , X = S , Se$

 $R_1 \sim R_4 = H$, CH_1 , C_1H_2

$$(CH_t)_n$$
 X
 X
 $(CH_t)_n$
 (II)

ZZKX = S, Se

n = 3 . 4

$$X_{x} = X_{x}$$

ZZK, X = S, Se

上配一般式 (I) において、 X = S , $R_i \sim R_i = H$ の 場合がTTFである。

上記例示によつて明らかなように、TTF類は その分子中にイオウヤセレンのような分極率の大 きい原子を含むイオン化ポテンシャルの低い化合 物である。とれらの中で最も単純な構造を有する

(7)

.ようなものに限定されることはない。この発明の . 場合の絶縁性ポリマーとして用いられるものを例 示すれば、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリカ ーポネート,ポリブロピレン,ポリエチレン,ポ リエチレンテレフタレート、ポリフェニレンオキ シド等である。界面分極の利用によつて高誘電率 化するためには、前述のように、電導性成分がポ リマー中に粒子状に分散することが重要であるか **ら、プレンドするCT餡体とポリマーとが完全に** 相称するのではなく、むしろ適度な親和性を有す る程度にとどまることが望ましい。この点、一般 にコンデンサ用ポリマーとして用いられているポ リスチレン。ポリスルホン等上掲の各ポリマーは、 CT錯体を均一に쯈解することができず、ミクロ に不均一に分散させるだけであるから、好ましい のである。

絶級性ポリマーに対するCT錯体の配合割合は、 10wtが以下、好ましくは7wtが以下である。CT 錯体の配合割合が10wtがを超えると、組成物は やはり高誘電率ではあるが低導性が増すため誘電 TTFのCT錯体が一般に殺も良い促導性を示す。

TTFの合成法については、すでに多くの学術文献に報告されている。この発明者らは、上野芳男氏らの方法(Synthesis 、1975、277かよび有機合成化学、24、958(1976) 参照)が反応条件がおだやかであり、かつ、収率も良いので、この方法およびこれに挙げる方法によつてTTF類の合成を行つた。

電荷移動錯体の電子アクセプターとしては、 TCNQその他のテトラシアノ化合物のほか、ョ ウ累、臭緊・塩素等のハロゲンや芳香族ニトロ化 合物等が用いられる。

絶録性ポリマーとしては、絶録性が高くかつ、 TTF類のCT鎖体とのプレンドによつて薄けれてつくることのできる高分子材料でありさえすれば 何でもよい。すなわち、絶録性ポリマーは熱での 性ポリマー・熱硬化性ポリマーのいずれであってが もよい。誘電体としては誘電損失の小さたが 望まれるので、絶録性ポリマーも通常は誘電失 の小さなもののなかから選ばれる。しかし、この

(8)

体として不適当となるからである。

この祭明にかかる高誘電率組成物の比抵抗値は、 絶縁性ポリマーの種類と、CT錯体の含量等の関係によつて穏々異なるが、誘電体としての性質か らすれば、一般には10¹⁰Ω-cm以上のものである ことが望ましい。

つぎに、プレンド法について説明する。

電導度(室温)

400

近子アクセプター

TCNQ

質子ドナー

TTF

一般に、TCNQ塩は、ジメチルホルムアミド (DMF), ジメチルアセトアミド(DM Ac). Nーメチルピロリドン系の容媒に容解しやすいの で、CT館体としてTCNQ塩を用いる場合は通 常とれらの쯈供が賞用されるが、これらに限定さ れるものではなく、テトラヒドロフラン,アセト ニトリル。アセトン、クロロホルムその他の溶媒 も単独であるいは混合して用いられる。均一でピ ンホールのないフィルムを作成するためには、む しろ、沸点差の異なる溶媒を混合して用いる方が 好ましいと替える。

TTF類を電子ドナーとする電荷移動錯体(CT 鎖体.)の室温における電導度の一例を示すと下記 第1表に示けとおりであり、いずれも、その単導 度が高いととが分かるo

(以下 余 白)

В TTF Br 200 C 10 TTF CI 0.1 T Se F* TCNQ E 800 TCNQ F 1000 TCNQ 500 G TCNQ 1000 Н TCNQ 2000

CT给兴本

Α

* TSeFとは下配の构造を備えた化合物である。

$$\binom{Se}{Se} = \binom{Se}{Se}$$

12

01)

TTF類のCT餅体は、このようにその電泳度 が極めて高いので、これを絶縁性ポリマーにプレ ンドしてなるプレンドポリマーは、通常の低分子 - T C N Q 塩 を 用いた プレンドポリマー に 比し、 周波数特性が極めて良く、高周波領域まで高級低 性を保持することができる。その理論的裏付けは、 Sillarsの不均質誘電体理論によつて説明すると とができる。 すなわち、 Sillars によると、図示 のような不均質誘電体において生じる界面分極の 援和時間では、

$$\tau = \frac{(n-1) \epsilon_1 + \epsilon_2}{\sigma_1}$$

で表わされる。ととで、nは分散粒子の形状因子 である。との式から、分散粒子Bの電導度 ogが増 すほど援和時間「が短くなることが分がる。他方、 この設和時間でと分極の緩和周波数fmとの間には、

$$r = \frac{1}{2\pi \text{ fm}}$$

の関係があるから、電導度なが増し緩和時間でが 短くなると、分種の緩和周波数fmが大きくなり、

そのため、髙周波領域までこの界面分極が有効と なるのである。

以上の説明によつて明らかにされたように、と の発明にかかる高勝電率組成物は、絶縁性ポリマ ー中に、TTF類を電子ドナーとする高電導性の CT錯体がプレンドされたものであり、有機物同 志のブレンド品であるから、界面での接着性が良 く、したがつて界面でポイドが生じることがない。 また、との高誘電率組成物は界面分極を利用する ものであるから、極めて高い誘電率化(cr = 20 ~100)が達成できる。さらに、この高誘電率 組成物は、TTF類を電子ドナーとする極めて高 い電導度を示けてT錯体を分散質とするものであ るから、高周波領域まで高勝電率を保持しりるの である。

なか、TTF類のCT錯体は Simple Salt であ る。したがつて、公知の他の高電導性TCNQ塩 たとえばNーメチルアクリジニウムーTCNQ塩 (Complex Salt) の場合そのTCNQ含量が 6 8 wtがと、高価なTCNQを多量に含みコストが嵩

特別 四54-163399 (5)

むほか、合成ステップも多くたるのに対し、TTF 類のTCNQ錯体は Simple Salt であるから、TCNQ 含量が少なくて資み、かつ、合成ステップも少な くなるという利点がある。

つぎに、この発明の契施例を説明する。 〔実施例1〕

まず、Synthesis 、 1975、277配収の方法によってTTFの中間体すなわち1、3ージチオールー2ーチオンをつくり、つぎに、有機合成化学34、958~963(1976年) 記敏の方法によって上記1、8ージチオールー2ーチオンからTTFを合成した。そして、脱酸器したアセトニトリル中でTTFとTCNQを熱時で均一溶液とした後放冷することによって、TTF-TCNQの1:1 錯体を析出させた。

このTTF-TCNQ錯体を末尾第2扱配数の配合で、ポリスチレンとジメチルホルムアミド中でプレンドし(固形分譲度約10wtが)均一に混合した後、この均一溶液をガラス板上にキャストし、10mmHg.空温で20時間乾燥し、さらに、

9 0 ℃で 2 0 時間 真空乾燥するととによつてサンブル № 1 , 2 のブレンドポリマーフィルムを得た。つぎに、 これらのフィルムの両面にアルミニウムを真空蒸浴して導電処理を施した後、室温における電気特性値を測定した。その結果は第 2 安に示すとおりである。

〔 與 施 例 2 〕

実施例1と同様にして得たTTF-TCNQ館体とポリスルホン(UCC社P-1700)とを、下記第3表記似の配合で実施例1と同様にしてブレンドすることによつて、サンブルNa3、4のブレンドポリマーフィルムを得た。つぎに、これらのフィルムの両面に実施例1と同様にして導質処理した後、室温における質気等性値を測定した結果は第3表に示すとおりである。

(以下余白)

45

16

| | | | Ř. | 4 | | | | |
|----------|------------|------------------|---|----------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| 1 3 | 1 | , | 85 | ø | * | 任 | | |
| 1972/マンド | E F | (n-cm) freq.(Hz) | 9 9 | 110 | 1 K | 1 0 K | 10K 100K | N I |
| | | 40 | 2 2.3 | 228 | 2 2.1 | 2 1.7 | 2 0.4 | 18.7 |
| <u> </u> | 101 | tan ô | 0.0039 | 0.0039 0.0049 0.0088 0.027 | 0.0088 | 0.027 | 0.049 | 0.049 0.095 |
| - | ; | w | 8 8.9 | 88.6 | 880 | 87.7 | 8 7.4 | 8 6.5 |
| <u> </u> | 10" | tan ô | 0.0062 0.0047 0.0086 0.0086 0.040 0.087 | 0.0047 | 0.0086 | 0.0066 | 0.040 | 0.087 |

| サンプル | サンノト 比似抗値 | | *** | F | ₩. | #1 | | |
|------|-----------|-----------|-------------|---|------------|-------|-------------|-----|
| ą | (ED-CE) | freq.(Hz) | 09 | 110 1K | 1 K | 1 0 K | 10K 100K 1k | _ |
| | 8108 | • | 2 5.8 | 2 5.8 | 26.2 | 25.0 | 24.8 | ~ |
| 0 | 10 | tan ô | 0.0088 | tan 8 0.0088 0.0040 0.0050 0.0065 0.0092 0.02 | 0.0050 | 00065 | 0.0 0 9 2 | 0.0 |
| | 110. | , | 9 1.1 | 9 1.0 | 9 0 8 | 0.0 8 | 8.8.5 | 8 |
| • | 2 | tan d | tan 8 0.050 | 0.0 6 0 | 00080 0017 | 0.017 | 0.044 | 0.0 |

-493-

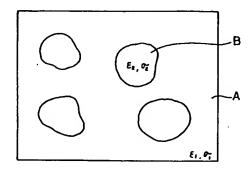
特朗 昭54-163399 (6)

4. 図面の簡単な説明

図面は界面分極が生じる高勝電率組成物の構造 模式図である。

A•••媒体 B•••與成分(電導性成分) 特許出願人 松下電工株式会社

代理人 弁理士 松 本 武 彦



(19)